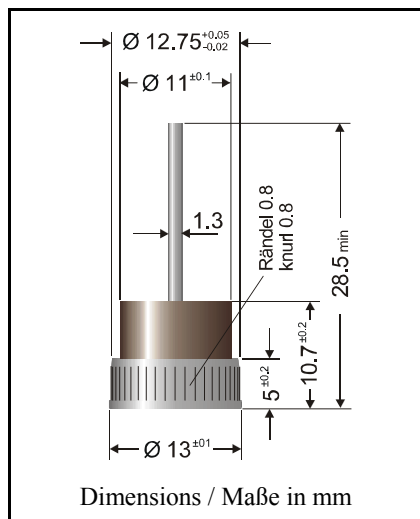


Silicon Press-Fit-Diodes
High-temperature diodes

Silizium-Einpreßdioden
Hochtemperaturdioden



Nominal current – Nennstrom 60 A

Repetitive peak reverse voltage 50...600 V
 Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with plastic cover
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Wire to / Draht an	Periodische Spitzensperrspanng.	Stoßspitzensperrspannung
Anode Cathode	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
BYP 60A05 BYP 60K05	50	60
BYP 60A1 BYP 60K1	100	120
BYP 60A2 BYP 60K2	200	240
BYP 60A3 BYP 60K3	300	360
BYP 60A4 BYP 60K4	400	480
BYP 60A6 BYP 60K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	60 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	120 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	450 / 500 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	1000 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+215 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	– 50...+215 °C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 60\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 0.6\text{ K/W}$

